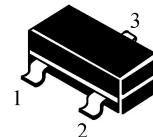


## 2SA1162

SOT-23

1. BASE
2. EMITTER
3. COLLECTOR



### ■ MAXIMUM RATINGS 最大額定值

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Rating 額定值	Unit 單位
Collector-Emitter Voltage 集電極-發射極電壓	$V_{CEO}$	-50	Vdc
Collector-Base Voltage 集電極-基極電壓	$V_{CBO}$	-50	Vdc
Emitter-Base Voltage 發射極-基極電壓	$V_{EBO}$	-5.0	Vdc
Collector Current-Continuous 集電極電流-連續	$I_C$	-150	mA

### ■ THERMAL CHARACTERISTICS 热特性

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Total Device Dissipation 總耗散功率 FR-5 Board(1)	$P_D$	225	mW
$T_A=25^\circ\text{C}$ 環境溫度為 $25^\circ\text{C}$ Derate above $25^\circ\text{C}$ 超過 $25^\circ\text{C}$ 遞減		1.8	$\text{mW}/^\circ\text{C}$
Total Device Dissipation 總耗散功率 Alumina Substrate 氧化鋁襯底,(2) $T_A=25^\circ\text{C}$ Derate above $25^\circ\text{C}$ 超過 $25^\circ\text{C}$ 遞減	$P_D$	300	mW
Thermal Resistance Junction to Ambient 熱阻	$R_{\theta JA}$	2.4	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Junction and Storage Temperature 結溫和儲存溫度	$T_J, T_{stg}$	-55 to +150 $^\circ\text{C}$	

### ■ DEVICE MARKING 打標

2SA1162  
 $H_{FE}:70-140=\text{SO}; 120-240=\text{SY}; 200-400=\text{SG}$



安徽富信半導體科技有限公司  
ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD

## 2SA1162

### ■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

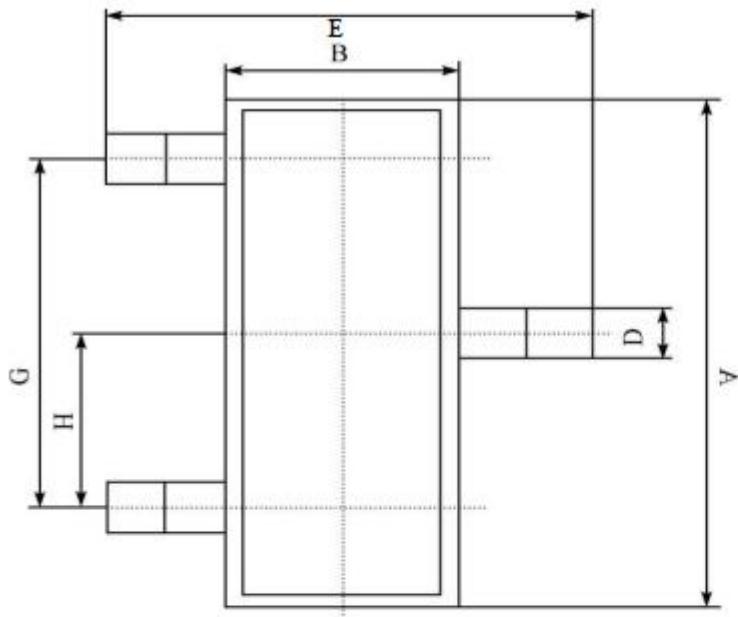
( $T_A=25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為  $25^\circ\text{C}$ )

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Type 典型值	Max 最大值	Unit 單位
------------------------	--------------	------------	-------------	------------	------------

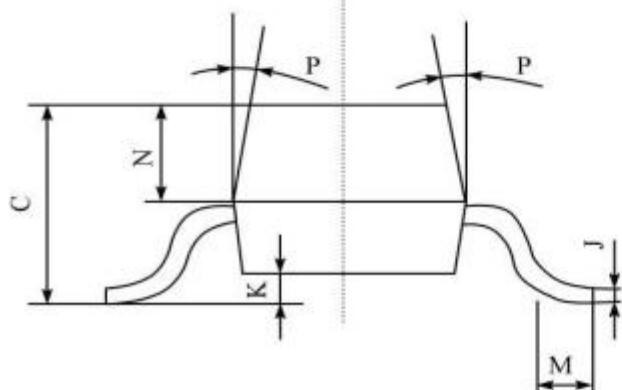
### ■OFF CHARACTERISTICS 截止電特性

Emitter Cutoff Current 發射極截止電流( $V_{EB}=-5.0\text{v}, I_C=0$ )	$I_{EBO}$	—	—	-0.1	$\mu\text{ A}$
Collector Cutoff Current 集電極截止電流( $V_{CB}=-50\text{v}, I_E=0$ )	$I_{CBO}$	—	—	-0.1	$\mu\text{ A}$
Collector Saturation Voltage 集電極飽和壓降( $I_C=-100\text{mA}, I_B=-10\text{mA}$ )	$V_{CE(\text{sat})}$	—	-0.1	-0.3	Vdc
DC Current Gain 直流電流增益( $V_{CE}=-6.0\text{v}, I_C=-2.0\text{mA}$ )	$H_{FE}$	70	—	400	
Gain Bandwidth Product 增益帶寬乘積( $V_{CE}=-10\text{v}, I_C=-1.0\text{mA}$ )	$f_T$	80	—	—	MHz
Noise Figure 噪聲係數 ( $V_{CE}=-6\text{V}, I_C=-0.1\text{mA}, f=1\text{kHz}, R_g=10\text{k}\Omega$ )	NF	—	1.0	10	dB
Output Capacitance 輸出電容 ( $V_{CB}=-10\text{v}, I_E=0, f=1.0\text{MHz}$ )	$C_{ob}$	—	4.0	7.0	pF

- FR-5=1.0×0.75×0.062in.
- Alumina=0.4×0.3×0.024in. 99.5%alumina.

**2SA1162**
**■DIMENSION 外形封裝尺寸**
**單位(UNIT): mm**


代碼	範圍(單位:mm)
A	2.80~3.00
B	1.20~1.40
C	0.90~1.10
D	0.30~0.50
E	2.20~2.60
G	1.80~2.00
H	0.90~1.00
J	0.08~0.18
K	0.02~0.12
M	≥0.22
N	0.50~0.70
P	6°~10°



# X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

***Click to view similar products for Bipolar Transistors - BJT category:***

***Click to view products by FOSAN manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[619691C](#) [MCH4017-TL-H](#) [MMBT-2369-TR](#) [BC546/116](#) [BC557/116](#) [BSW67A](#) [NJVMJD148T4G](#) [NTE123AP-10](#) [NTE153MCP](#) [NTE16](#)  
[NTE195A](#) [NTE92](#) [C4460](#) [2N4401-A](#) [2N6728](#) [2SA1419T-TD-H](#) [2SA2126-E](#) [2SB1204S-TL-E](#) [2SC2712S-GR,LF](#) [2SC5488A-TL-H](#)  
[2SD2150T100R](#) [SP000011176](#) [2N2907A](#) [2N3904-NS](#) [2N5769](#) [2SC2412KT146S](#) [2SD1816S-TL-E](#) [CPH6501-TL-E](#) [MCH4021-TL-E](#)  
[MJE340](#) [US6T6TR](#) [NJK0281DG](#) [732314D](#) [CPH3121-TL-E](#) [CPH6021-TL-H](#) [873787E](#) [IMZ2AT108](#) [UMX21NTR](#) [MCH6102-TL-E](#)  
[NJK0302DG](#) [2N3583](#) [30A02MH-TL-E](#) [NSV40301MZ4T1G](#) [NTE13](#) [NTE26](#) [NTE282](#) [NTE323](#) [NTE350](#) [NTE81](#) [STX83003-AP](#)